

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет Електроніки
Кафедра мікроелектроніки

ЗВІТ
Про виконання самостійної роботи №5
з дисципліни: «Схемотехніка-1»

Виконавець:
Студент 3-го курсу

(підпис)

А. С. Мнацаканов

Перевірила:

(підпис)

І. П. Голубєва

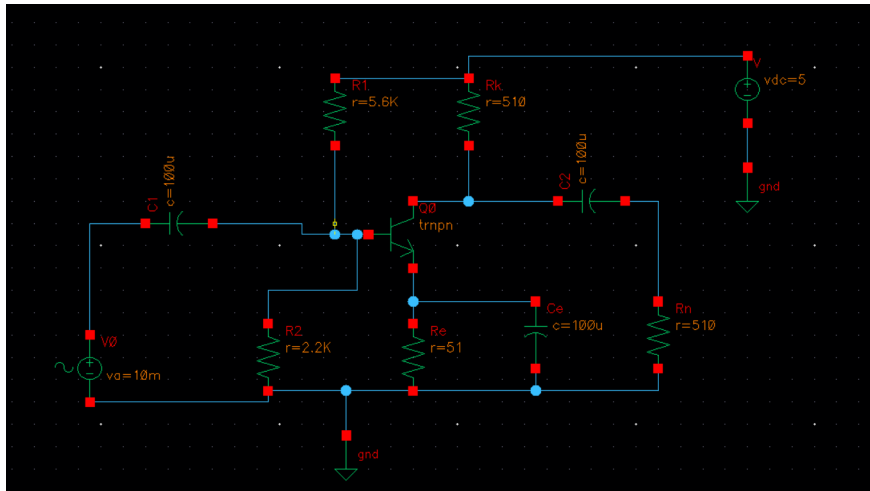


Рис. 1: Схема транзисторного підсилювача, включеного по схемі спільного емітера

Обрав робочу точку Q:

$$\begin{aligned} U_{KE0} &= 2,5 \text{ В} \\ I_{K0} &= 4,3 \text{ мА} \\ U_{BE0} &= 0,855 \text{ В} \\ I_{B0} &= 200 \text{ мкА} \end{aligned}$$

Розрахунок деяких параметрів:

$$h_{11} = 0,57 \text{ КОМ}$$

$$R_e = 51 \text{ ОМ}$$

$$R_k = 510 \text{ ОМ}$$

$$R_2 = 2,2 \text{ КОМ}$$

$$I_{R_1} = 0,00068831 \text{ А}$$

$$R_1 = 5,6 \text{ КОМ}$$

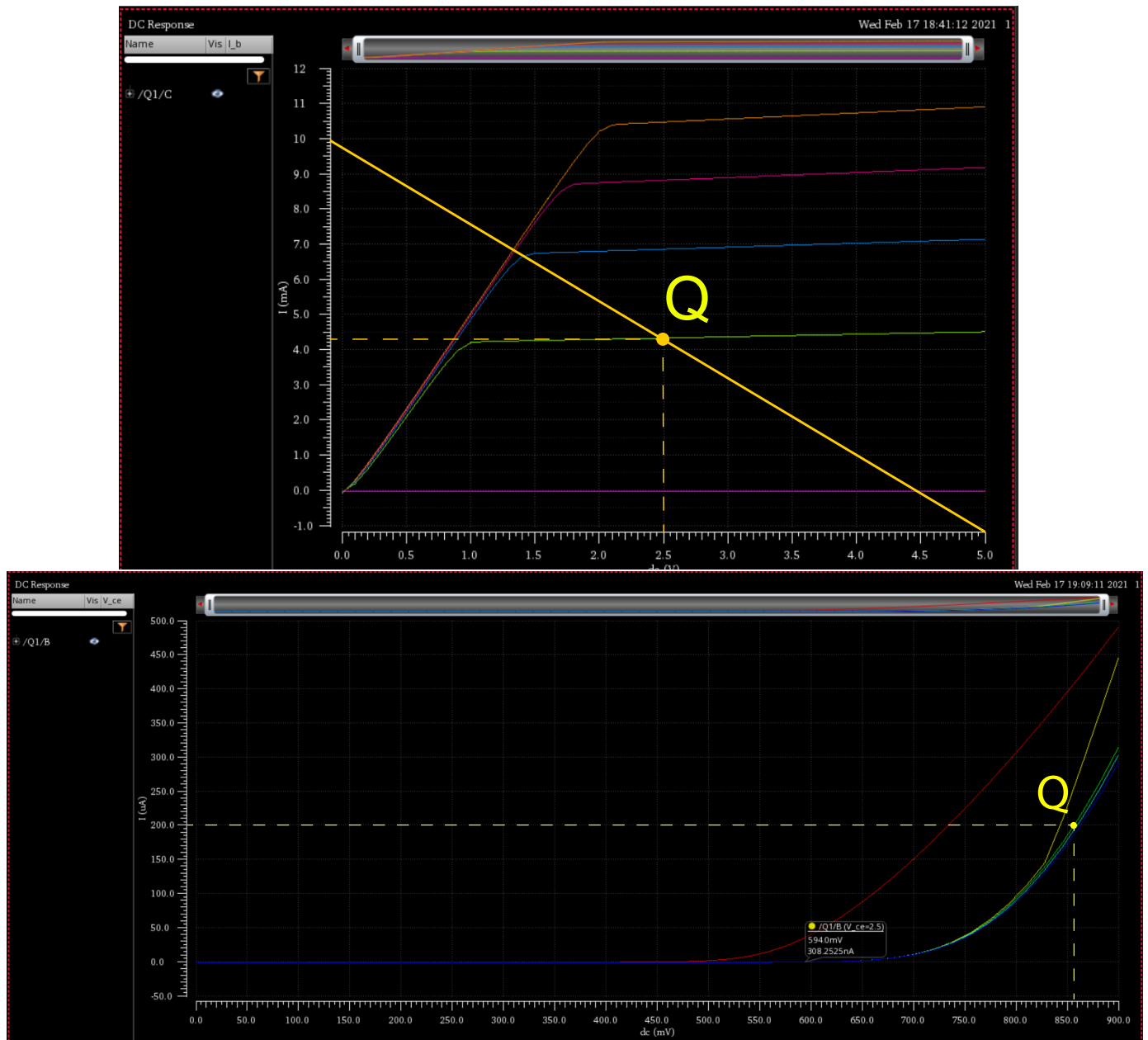


Рис. 2: ВАХ біполярного транзистора

